

## CM2N60C N 沟道 VDMOS

### \* 主要用途:

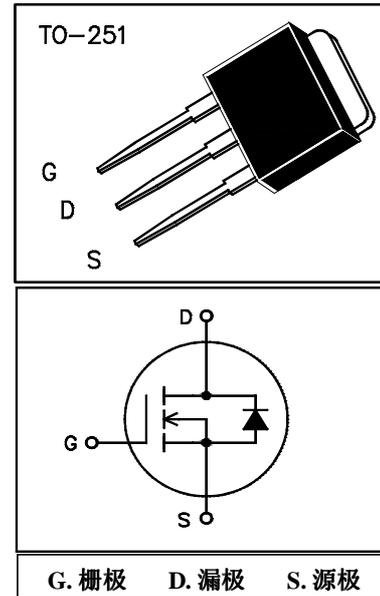
- ◆ 主要用于电源适配器、线性放大和功率开关电路

### \* 主要特点:

- ◆ 通态电阻小, 输入电容小
- ◆ 开关速度快
- ◆ 100% 雪崩能量测试

### \* 注意:

- ◆ 防静电



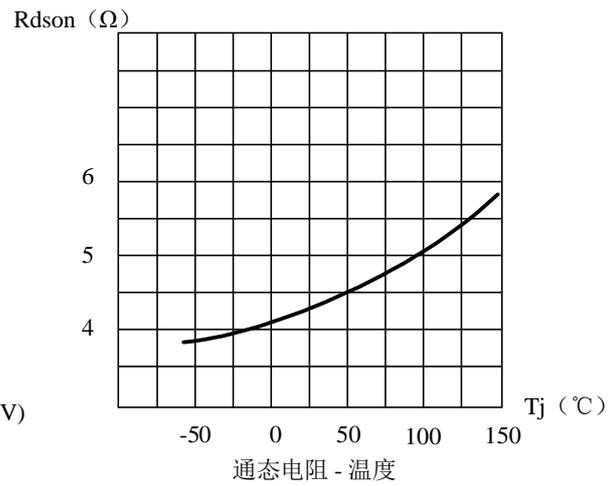
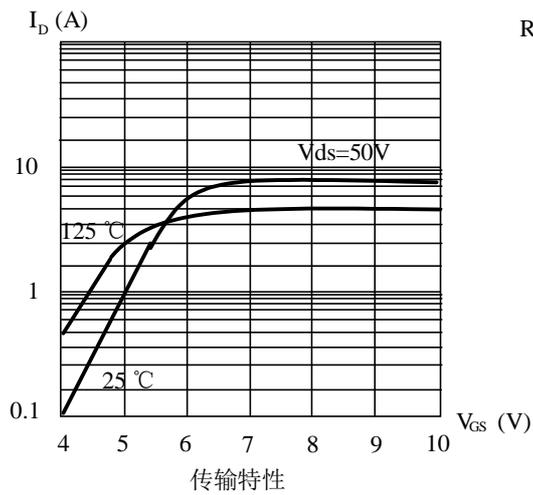
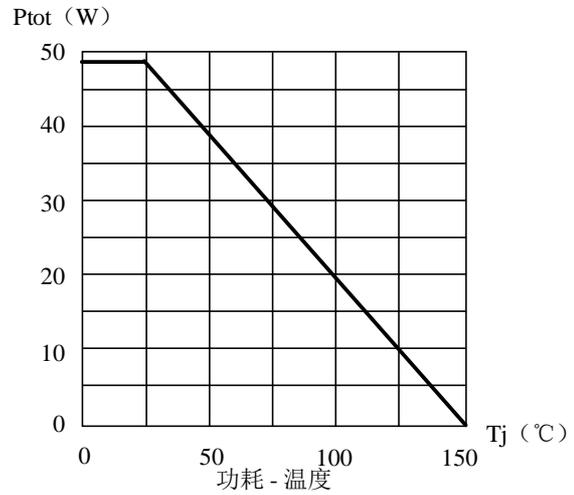
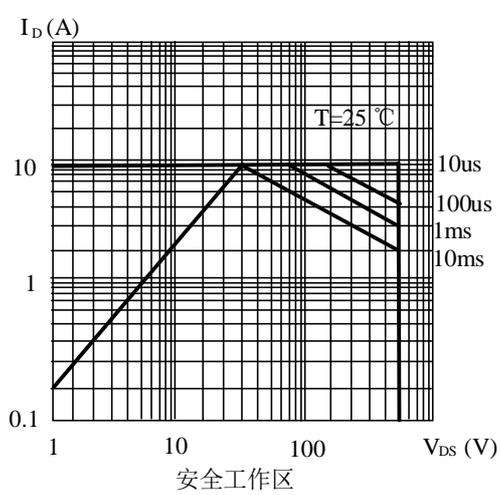
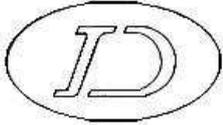
### 极限值: (Tc=25 °C)

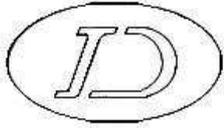
参数名称	符号	额定值	单位
连续漏极电流	I <sub>D</sub>	2.0	A
栅源电压	V <sub>GS</sub>	±30	V
雪崩电流	I <sub>AR</sub>	2.2	A
热阻 (结到壳)	R <sub>θJC</sub>	2.5	°C/W
耗散功率	P <sub>tot</sub>	48	W
结温	T <sub>jm</sub>	150	°C
贮存温度	T <sub>stg</sub>	- 55 ~ 150	°C

### 电特性: (Tc=25 °C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	V <sub>DS</sub>	V <sub>GS</sub> =0V, I <sub>D</sub> =250uA	600			V
通态电阻	R <sub>DS(on)</sub>	V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1.2A			4.4	Ω
阈值电压	V <sub>GS(th)</sub>	V <sub>DS</sub> =V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> =250uA	2		4	V
跨导	g <sub>FS</sub>	V <sub>DS</sub> =50V, I <sub>D</sub> =1.0A	1.4			S
漏源漏电流	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =600V, V <sub>GS</sub> =0V			25	uA
栅源漏电流	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> =±30V			±100	nA
关断延迟时间	td (off)	V <sub>DD</sub> =300V, I <sub>D</sub> =2.0A R <sub>G</sub> =18Ω, R <sub>D</sub> =150Ω		30		nS
输入电容	C <sub>iss</sub>	V <sub>GS</sub> =0V, V <sub>DS</sub> =25V f=1.0MHZ		350		pF

a: 脉冲测试: t<sub>p</sub> ≤ 300us, δ ≤ 2%





## 封装形式:

**TO-251** (单位: mm, 无其他特别说明公差  $\pm 0.1\text{mm}$ )

